

FG-FET Berbasis Film Ag₂O Untuk Pendeteksian H₂S

Title	FG-FET Berbasis Film Ag ₂ O Untuk Pendeteksian H ₂ S
Author Order	2 of 3
Accreditation	
Abstract	<p>Film Ag₂O telah ditumbuhkan pada top electrode Si/Ti/Pt dengan evaporasi termal. Proses evaporasi dilakukan pada tekanan 2•10⁻² mbar dalam atmosfer oksigen sintesis. SEM digunakan untuk menganalisa struktur permukaan film. Top electrode dilekatkan pada chip FG-FET untuk membentuk sebuah sensor gas yang sensitif terhadap H₂S. Karakterisasi yang meliputi uji temperatur, konsentrasi, kelembaban dan selektivitas dilakukan untuk mengetahui kehandalan sensor. Hasil karakterisasi menunjukkan bahwa FG-FET berbasis film Ag₂O dapat mendeteksi H₂S pada konsentrasi rendah dengan temperatur operasi optimum 95°C dalam keadaan kering maupun lembab. Penambahan klaster Fe pada permukaan film Ag₂O dapat meningkatkan unjuk kerja sensor yang ditandai dengan peningkatan sinyal keluaran sensor.</p> <p>Keywords: FG-FET, Film Ag₂O, Fe, Fungsi Kerja, H₂S</p>
Publisher Name	Pusat Teknologi Instrumentasi dan Otomasi (PTIO) Institut Teknologi Bandung
Publish Date	2012-04-11
Publish Year	2011
Doi	DOI: 10.5614/joki.2011.3.2.3
Citation	
Source	Jurnal Otomasi, Kontrol, dan Instrumentasi
Source Issue	Vol 3 No 2 (2011): Jurnal Otomasi, Kontrol, dan Instrumentasi
Source Page	87
Url	http://journals.itb.ac.id/index.php/joki/article/view/3941/2009
Author	Dr BILALODIN, S.Si, M.Si